




| | |
|---|--|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: SI5513CDC-T1-GE3</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p> |
| | <p>Datenblätter:  SI5513CDC-T1-GE3.pdf</p> |
| <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> | |
| <p>Lagerzustand: New original, 513 pcs Stock Available.</p> | |
| <p>Liefern von: Hong Kong</p> | |
| <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | SI5513CDC-T1-GE3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 513 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.5V @ 250µA |
| Supplier Device-Gehäuse | 1206-8 ChipFET™ |
| Serie | TrenchFET® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 4.4A, 4.5V |
| Leistung - max | 3.1W |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-SMD, Flat Lead |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 285pF @ 10V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 4.2nC @ 5V |
| Typ FET | N and P-Channel |
| FET-Merkmal | Logic Level Gate |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 20V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 4A, 3.7A |

SI5513CDC-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5513CDC-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5513CDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5513CDC-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>SI5511DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p> |  <p>SI5513CDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p> |  <p>SI5513DC VISHAY SI5513DC VISHAY</p> |  <p>SI5513CDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p> |
|  <p>SI5513DC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N/P-CH 20V 3.1A 1206-8</p> |  <p>SI5511DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 30V 4A 1206-8</p> |  <p>SI5513CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N/P-CH 20V 4A 1206-8</p> |  <p>SI5513DC-T1 VISHAY SI5513DC-T1 VISHAY</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| SI5513CDC-T1-GE3 Vishay / Siliconix | SI5513CDC-T1-GE3 Datenblatt | SI5513CDC-T1-GE3-Datenblätter | SI5513CDC-T1-GE3 PDF | Vishay / Siliconix SI5513CDC-T1-GE3 |
| SI5513CDC-T1-GE3 Electronic | SI5513CDC-T1-GE3-Komponenten | SI5513CDC-T1-GE3-Verteiler | SI5513CDC-T1-GE3-Bild | SI5513CDC-T1-GE3-Teil |
| SI5513CDC-T1-GE3 Preis | SI5513CDC-T1-GE3 Hersteller | SI5513CDC-T1-GE3 Bild | SI5513CDC-T1-GE3 Aktie | SI5513CDC-T1-GE3 Inventar |
| SI5513CDC-T1-GE3 Neu | SI5513CDC-T1-GE3 Original | SI5513CDC-T1-GE3 garantiert | SI5513CDC-T1-GE3 RFQ | SI5513CDC-T1-GE3 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited